

من الضروري معرفة الحل الامثل لمعادلات لاوي ومواصفات $\vec{\Delta k}$ لكي نحصل على عملية الحيود للاشعة السينية. ويكون حل معادلات لاوي سهلا اذا كانت المحاور الأساسية $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ في البلورة متعامدة مع بعضها كما هو الحال في الانظمة البلورية المكعبة و الرباعية والمعينية القائمة، وبذلك تصبح معادلات لاوي بالشكل:

$$\vec{\Delta k} = \hat{i} \frac{v_1}{a} + \hat{j} \frac{v_2}{b} + \hat{k} \frac{v_3}{c}$$

حيث ان $\hat{k}, \hat{j}, \hat{i}$ تمثل الوحدات الاتجاهية باتجاه المحاور البلورية $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$.

وهكذا نرى الحاجة للتعامل مع الشبيكة المقلوبة حيث ابعاد المتجهات في الشبيكة المقلوبة (فضاء k)

هي مقلوب الطول في الفضاء الحقيقي (الشبيكة الحقيقية). ولاثبات ذلك نستخدم المفاهيم السابقة وكما يلي:

ان النقطة في الشبيكة الحقيقية يعبر عنها بالمتجه $\vec{r} = (n_1\vec{a} + n_2\vec{b} + n_3\vec{c})$ ، والنقطة في

الشبيكة المقلوبة يعبر عنها بالمتجه $\vec{G} = v_1\vec{A} + v_2\vec{B} + v_3\vec{C}$ و عليه فإن:

$$\begin{aligned} \vec{r} \cdot \vec{G} &= (n_1\vec{a} + n_2\vec{b} + n_3\vec{c}) \cdot (v_1\vec{A} + v_2\vec{B} + v_3\vec{C}) \\ &= n_1v_1(\vec{a} \cdot \vec{A}) + n_2v_2(\vec{b} \cdot \vec{B}) + n_3v_3(\vec{c} \cdot \vec{C}) \end{aligned}$$

ومن خصائص الشبيكة المقلوبة (الصفحة رقم ٥٨ النقطة رقم ٢) نجد ان:

$$\begin{aligned} \vec{r} \cdot \vec{G} &= n_1v_1(2\pi) + n_2v_2(2\pi) + n_3v_3(2\pi) \\ &= 2\pi(n_1v_1 + n_2v_2 + n_3v_3) = 2\pi\varepsilon \end{aligned}$$

وهكذا فعندما $\vec{r} \cdot \vec{G} = 2\pi\varepsilon$ ، فان \vec{G} يحقق شرط الحيود في الشبيكة المقلوبة $\vec{G} = \vec{\Delta k}$ ، حيث ان:

$$n_1v_1 + n_2v_2 + n_3v_3 = \varepsilon$$

١٠-كرة ايوالد لتفسير ظاهرة الحيود

ربط العالم ايوالد فكرة الشبيكة المقلوبة مع فكرة كرة الانعكاس والتي اطلق عليها كرة ايوالد لتفسير

النتائج التجريبية لحيود الاشعة السينية من المستويات البلورية ، حيث يمكن معرفة المستوي الذي يعمل على

استطارة الاشعة السينية من معرفة اتجاه وقيمة الطول الموجي للاشعة الساقطة.

ويمكن رسم كرة ايوالد كما يلي:

١- نحدد الطول الموجي λ للموجة الساقطة واتجاهه.

٢- نعين نقطة اصل O لفضاء الشبكة المقلوبة .

٣- نرسم متجه طولهُ $\frac{1}{\lambda}$ واتجاهه باتجاه الشععة الساقطة، وليكن \vec{OA}

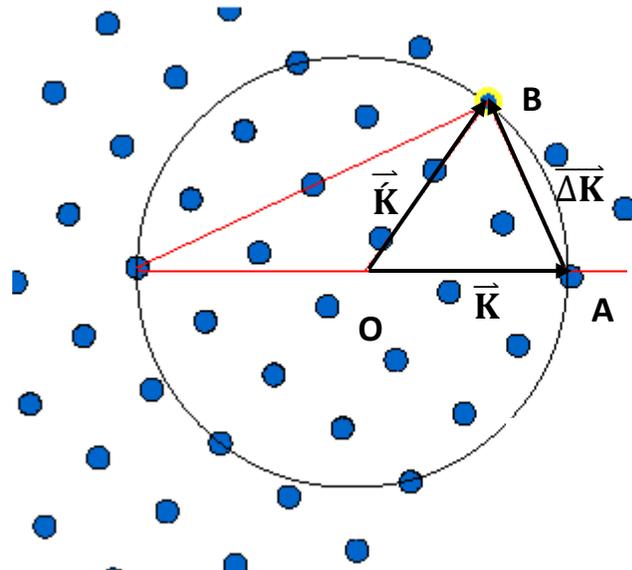
٤- نرسم دائرة نصف قطرها \vec{OA} ومركزها يقع عند نقطة الأصل O على شرط ان يمر محيط الدائرة بعدد

من نقاط الشبكة المقلوبة. حيث ان كل نقطة تقع على سطح الكرة تحقق شرط الحيود.

\vec{K} متجه الموجة الساقطة

\vec{K}' متجه الموجة الحائدة

$$\vec{K}' - \vec{K} = \vec{\Delta K} = \vec{G}$$



حيث \vec{G} متجه الانتقال في الشبكة المقلوبة، ويمكن كتابة K' كالاتي: $\vec{K}' = \vec{G} + \vec{K}$ وبتربيع الطرفين:

$$\vec{K}' \cdot \vec{K}' = (\vec{G} + \vec{K}) \cdot (\vec{G} + \vec{K}) \Rightarrow |\vec{K}'|^2 = |\vec{G}|^2 + |\vec{K}|^2 + 2\vec{G} \cdot \vec{K}$$

وبما ان $|\vec{K}'| = |\vec{K}|$ (كلاهما نصف قطر) ، لذا فان:

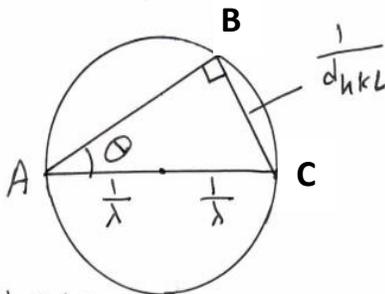
$$|\vec{G}|^2 + 2\vec{G} \cdot \vec{K} = 0$$

وهي معادلة براغ في الشبكة المقلوبة

ولاثبات ذلك: بما ان شرط الحيود في الشبكة المقلوبة هو: $\vec{\Delta K} = \vec{G} = \frac{1}{d_{hkl}}$ و $\vec{K} = \frac{1}{\lambda}$ ، ومن

القوانين الهندسية فان المثلث ABC قائم الزاوية في B ، وعليه:

$$\sin \theta = \frac{BC}{AC} = \frac{1/d_{hkl}}{2/\lambda} \Rightarrow \lambda = 2d_{hkl} \sin \theta$$



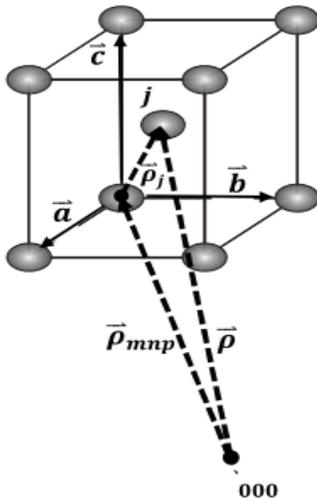
التصميم لبيبي لمانون بال

١١ - عامل التركيب للاساس (عامل التركيب الهندسي) Structure factor Calculation

من المعروف ان شدة الحزمة المستطارة تعتمد على:

- محتويات مركز الاستطارة (الاساس) أي على عدد الذرات الموجودة في الاساس
- موضع الذرة
- توزيع الالكترونات على هذه الذرة.

ولايجاد علاقة رياضية بين شدة الحزمة المستطارة ومواقع الذرات داخل الاساس ، نفرض ان وحدة خلية لبلورة معينة تحتوي على S من الذرات وان موقع الذرة الواحدة يعرف بالمتجه $\vec{\rho}_j$ من نقطة أصل وحدة الخلية الى الذرة j ، وحدة الخلية معرفة بالمتجه $\vec{\rho}_{mnp}$ المحدد من نقطة الأصل الرئيسية للبلورة 0,0,0 حيث ان:



$$\vec{\rho}_j = x_j \vec{a} + y_j \vec{b} + z_j \vec{c}$$

$$\vec{\rho}_{mnp} = m \vec{a} + n \vec{b} + p \vec{c}$$

من المعلوم ان الالكترونات لا تتركز في نقطة واحدة بل تتوزع حول النواة لذا يمكن التعبير عن توزيع الالكترونات داخل البلورة بالشكل الاتي، فاذا كانت $n_j(\vec{\rho} - \vec{\rho}_j)$ يمثل مساهمة الذرة j بالكثافة الالكترونية في نقطة معينة محددة بالمتجه $\vec{\rho}$ ، والكثافة الالكترونية الكلية لنتيجة من مساهمة كل الذرات في الخلية تعطى:

$$n_j(\vec{\rho}) = \sum_{j=1}^S n_j(\vec{\rho} - \vec{\rho}_j)$$

وعندما يكون شرط الحيود متحقق $\vec{\Delta K} = \vec{G}$ يمكن تعريف سعة الموجة المستطيرة F_G لعدد N من وحدات الخلية داخل البلورة وفقا للعلاقة الاتية:

$$F_G = N \int dV n_j(\vec{\rho}) e^{-i\vec{G} \cdot \vec{\rho}}$$

حيث ان التكامل أعلاه على وحدة خلية واحدة، وهو يمثل عامل التركيب S_G ويمكن كتابة المعادلة أعلاه،

$$F_G = N S_G$$

ومن تعريف $n_j(\vec{\rho})$ تصبح المعادلة،

$$F_G = N \int dV \sum_{j=1}^S n_j(\vec{\rho} - \vec{\rho}_j) e^{-i\vec{G} \cdot \vec{\rho}}$$

$$F_G = N \sum_{j=1}^S \int dV n_j (\vec{\rho} - \vec{\rho}_j) e^{-i\vec{G}\cdot\vec{\rho}}$$

نفرض ان: $\vec{R} = \vec{\rho} - \vec{\rho}_j$ ، فيمكن كتابة معادلة F_G بالشكل:

$$F_G = N \sum_{j=1}^S \int dV n_j (\vec{R}) e^{-i\vec{G}\cdot\vec{R}} e^{-i\vec{G}\cdot\vec{\rho}_j} = N \sum_{j=1}^S f_j e^{-i\vec{G}\cdot\vec{\rho}_j} = N S_G$$

ويعرف عامل التشكيل الذري *Atomic form factor* $f_j = \int dV n_j (\vec{R}) e^{-i\vec{G}\cdot\vec{R}}$ هذا التكامل يكون على كل الفضاء للبلورة. وهكذا يمكن إعادة كتابة عامل التركيب للاساس وكما يلي:

$$S_G = \sum_{j=1}^S f_j e^{-i\vec{G}\cdot\vec{\rho}_j}$$

$$\vec{\rho}_j = x_j \vec{a} + y_j \vec{b} + z_j \vec{c}$$

$$\vec{G} = \nu_1 \vec{A} + \nu_2 \vec{B} + \nu_3 \vec{C}$$

$$\vec{\rho}_j \cdot \vec{G} = (x_j \vec{a} + y_j \vec{b} + z_j \vec{c}) \cdot (\nu_1 \vec{A} + \nu_2 \vec{B} + \nu_3 \vec{C})$$

باستخدام خصائص الشبكة المقلوبة.

$$\vec{\rho}_j \cdot \vec{G} = 2\pi (x_j \nu_1 + y_j \nu_2 + z_j \nu_3)$$

وعليه

$$S_G = \sum_{j=1}^S f_j e^{-i2\pi(x_j \nu_1 + y_j \nu_2 + z_j \nu_3)}$$

وعليه تكون S_G بدلالة ν_1, ν_2, ν_3 ، $S_G = S_{\nu_1 \nu_2 \nu_3}$

ملاحظة:

- لا تكون S_G بالضرورة مقدار حقيقي.
- سعة الاستطارة تحسب من العلاقة $F = S_G^* S_G$.
- عندما تكون $S_G = 0$ فان شدة الاستطارة تساوي صفر أيضا.
- $(\nu_1 \nu_2 \nu_3) \equiv (hkl)$ حيث hkl هي معاملات ميلر
- فاذا تكلمنا عن ν_1, ν_2, ν_3 فاننا نتكلم عن اعداد ميلر واستخدمنا هذه الرموز لغرض التعميم.
- وأيضا متجه الانتقال في الشبكة الحقيقية $\vec{T} \equiv \vec{\rho}_{mnp}$.

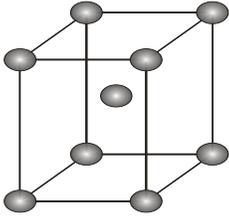
مثال 1: ان ابسط وحدات الخلية في البلورة هي تلك التي فيها ذرة واحدة ذات احداثيات $(0,0,0)$. جد عامل التركيب وشدة الاستطارة لها.

$$S_G = S_{v_1 v_2 v_3} = \sum_{j=1}^1 f_{000} e^{-2\pi i (0v_1 + 0v_2 + 0v_3)} = f$$

$$S_G^2 = f f^* = f^2 \quad \text{شدة الاستطارة}$$

=====

مثال 2: وحدة خلية مكعبة متركزة الجسم BCC تحتوي على ذرتين من نوع واحد احداثياتهما:



$$x_1 = y_1 = z_1 = 0 \quad \text{و} \quad x_2 = y_2 = z_2 = \frac{1}{2}$$

احسب عامل التركيب.

$$S_G = \sum_{j=1}^2 f_j e^{-2\pi i (x_j v_1 + y_j v_2 + z_j v_3)}$$

الحل:

$$= f_{000} e^{-2\pi i (0)} + f_{\frac{111}{222}} e^{-2\pi i \left(\frac{v_1}{2} + \frac{v_2}{2} + \frac{v_3}{2}\right)}$$

$$f_{000} = f_{\frac{111}{222}} = f, \quad \text{وبما ان هناك نوع واحد من الذرات فان،}$$

$$S_G = f(1 + e^{-\pi i (v_1 + v_2 + v_3)})$$

$$S_G = f(1 + e^{-\pi i (even)}) \quad \text{فان عدد زوجي = حاصل الجمع}$$

$$|S_G|^2 = 4f^2$$

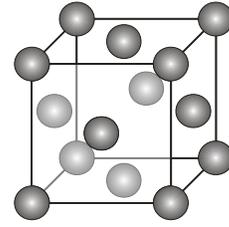
$$S_G = f(1 + e^{-\pi i (odd)}) = 0 \quad \text{فان عدد فردي = حاصل الجمع}$$

$$S_G^2 = 0 \quad \text{وهذا يعني انه لا تحدث عملية انعكاس}$$

مثال 3: وحدة خلية مكعبة متركزة الواجه FCC تحتوي على 4 ذرات من نوع واحد احداثياتها:

$$(0,0,0), \left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$$

احسب عامل التركيب وشدة الاستطارة.

الحل:

$$S_G = \sum_{j=1}^4 f_j e^{-2\pi i(x_j v_1 + y_j v_2 + z_j v_3)}$$

$$= f_{000} e^{-2\pi i(0)} + f_{0\frac{11}{22}} e^{-2\pi i(\frac{v_2 + v_3}{2})} + f_{\frac{1}{2}0\frac{1}{2}} e^{-2\pi i(\frac{v_1 + v_3}{2})} + f_{\frac{11}{22}0} e^{-2\pi i(\frac{v_1 + v_2}{2})}$$

وبما ان هناك نوع واحد من الذرات فان، $f_{000} = f_{0\frac{11}{22}} = f_{\frac{1}{2}0\frac{1}{2}} = f_{\frac{11}{22}0} = f$

$$S_G = f(e^{-2\pi i(0)} + e^{-\pi i(v_2 + v_3)} + e^{-\pi i(v_1 + v_3)} + e^{-\pi i(v_1 + v_2)})$$

فاذا كانت $v_2 + v_3 = \text{even}$, $v_1 + v_3 = \text{even}$, $v_1 + v_2 = \text{even}$

$$S_G = f(1 + 1 + 1 + 1) = 4f \quad \Rightarrow \quad S_G^2 = 16f^2$$

اما اذا كانت v_1, v_2, v_3 من النوع المختلط زوجي وفردى فان عامل التركيب $S_G = 0$ وكذلك شدة الاستطارة. وهذا يعني عدم حدوث انعكاس. مثلا v_1, v_2 اعداد زوجية و v_3 عدد فردي فان:

$$S_G = f(e^{-2\pi i(0)} + e^{-\pi i(\text{odd})} + e^{-\pi i(\text{odd})} + e^{-\pi i(\text{even})})$$

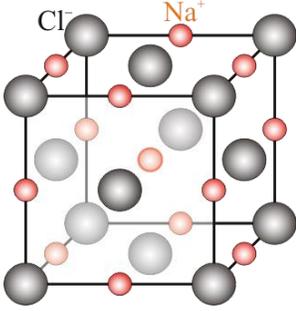
$$S_G = f(1 - 1 - 1 + 1) = 0$$

مثال 4: تركيب بلوري متركز الأوجه FCC يحتوي على المستويات (100), (110), (111), (200), (112), (220), (210)، بين أي من هذه المستويات يحدث عنها انعكاس؟.

الحل: من المثال الخاص بوحدة خلية FCC وجدنا ان: لكي يحدث الانعكاس يجب ان يكون (v_1, v_2, v_3) او (hkl) جميعها اعداد فردية odd او جميعها اعداد زوجية even . اذن تكون المستويات التي يحدث منها انعكاس هي: (111), (200), (220) فقط .

مثال 5: احسب عامل التركيب الأساسي و شدة الاستطارة لوحدة خلية بلورة كلوريد الصوديوم $NaCl$.

الحل: من المعروف ان وحدة خلية بلورة كلوريد الصوديوم عبارة عن مكعب متمركز الأوجه يحتوي على 4 ذرات Na و 4 ذرات Cl . ووحدة الخلية مكونة من مكعبين متمركزي الأوجه كل مكعب يحتوي على نوع واحد من الذرات (Na او Cl) هذين المكعبين مزاح احدهما عن الاخر بمقدار $\frac{1}{2}$ وحدة.



احداثيات المكعب الأول (Na): $(0,0,0), (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}), (\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}), (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$

احداثيات المكعب الثاني (Cl): $(\frac{1}{2}, 0, 0), (0, \frac{1}{2}, 0), (0, 0, \frac{1}{2}), (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

$$S_G = \sum_{j=1}^8 f_j e^{-2\pi i(x_j v_1 + y_j v_2 + z_j v_3)}$$

$$= f_{Na} \left\{ e^{-2\pi i(0)} + e^{-2\pi i(\frac{v_2 + v_3}{2})} + e^{-2\pi i(\frac{v_1 + v_3}{2})} + e^{-2\pi i(\frac{v_1 + v_2}{2})} \right\}$$

$$+ f_{Cl} \left\{ e^{-2\pi i(\frac{v_1}{2})} + e^{-2\pi i(\frac{v_2}{2})} + e^{-2\pi i(\frac{v_3}{2})} + e^{-2\pi i(\frac{v_1 + v_2 + v_3}{2})} \right\}$$

$$= f_{Na} \{ 1 + e^{-\pi i(v_2 + v_3)} + e^{-\pi i(v_1 + v_3)} + e^{-\pi i(v_1 + v_2)} \}$$

$$+ f_{Cl} \{ e^{-\pi i(v_1)} + e^{-\pi i(v_2)} + e^{-\pi i(v_3)} + e^{-\pi i(v_1 + v_2 + v_3)} \}$$

قيمة S_G تعتمد على قيم v_1, v_2, v_3 فيما اذا كانت فردية ام زوجية:

١- عندما تكون v_1, v_2, v_3 كلها اعداد صحيحة فردية فان:

$$S_G = f_{Na} \{ 1 + 1 + 1 + 1 \} + f_{Cl} \{ -1 - 1 - 1 - 1 \}$$

$$S_G = 4(f_{Na} - f_{Cl}) \Rightarrow S_G^2 = 16(f_{Na} - f_{Cl})^2$$

٢- عندما تكون ν_1, ν_2, ν_3 كلها اعداد صحيحة زوجية فان:

$$S_G = f_{Na}\{1 + 1 + 1 + 1\} + f_{Cl}\{1 + 1 + 1 + 1\}$$

$$S_G = 4(f_{Na} + f_{Cl}) \quad \Rightarrow \quad S_G^2 = 16(f_{Na} + f_{Cl})^2$$

بالمقارنة بين شدة الاستطارة في حالة الاعداد كلها الفردية odd وحالة الاعداد كلها الزوجية even نجد ان:

$$S_{odd}^2 = 16(f_{Na} - f_{Cl})^2 < S_{even}^2 = 16(f_{Na} + f_{Cl})^2$$

معنى ذلك ان الشدة في حالة الاعداد كلها الفردية مثل (111), (311) اضعف مما هي في حالة الاعداد كلها الزوجية مثل (200), (222)

٣- عندما تكون ν_1, ν_2, ν_3 اعداد صحيحة مختلطة زوجية وفردية مثلاً: ν_1 فردي و ν_2, ν_3 زوجية لكلا الذرتين فان،

$$S_G = f_{Na}\{1 + 1 - 1 - 1\} + f_{Cl}\{-1 + 1 + 1 - 1\}$$

$$S_G = 0$$

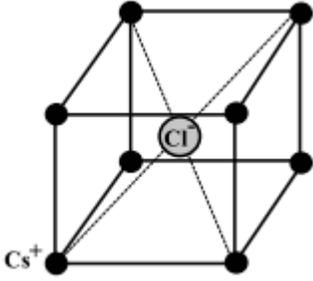
$$S_G^2 = 0$$

وهذا يعني عندما تكون ν_1, ν_2, ν_3 اعداد صحيحة مختلطة زوجية وفردية مثل (100), (211) لا يحدث انعكاس والشدة تساوي صفر.

مثال 6: احسب عامل التركيب الأساسي و شدة الاستطارة لوحدة خلية بلورة كلوريد السيزيوم $CsCl$ وهي من نوع مكعب متمركز الجسم حيث توجد في كل وحدة خلية ايون سيزيوم موضوع عند $(0,0,0)$ وايون

كلور عند $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

الحل:



$$S_G = f_{sc} e^{-2\pi i(0)} + f_{cl} e^{-2\pi i(\frac{v_1}{2} + \frac{v_2}{2} + \frac{v_3}{2})}$$

فاذا كان حاصل الجمع $v_1 + v_2 + v_3 = \text{عدد زوجي}$ فان $S_G = f_{sc} + f_{cl} e^{-\pi i(\text{even})} = \dots$

$$|S_G|^2 = \dots$$

فاذا كان حاصل الجمع $v_1 + v_2 + v_3 = \text{عدد فردي}$ فان $S_G = f_{sc} + f_{cl} e^{-\pi i(\text{odd})} = \dots$

$$S_G^2 = \dots$$

ناقش الحل

وماذا ستكون نتائج الشدة وعامل التركيب في حالة كون $f_{sc} = 3f_{cl}$.